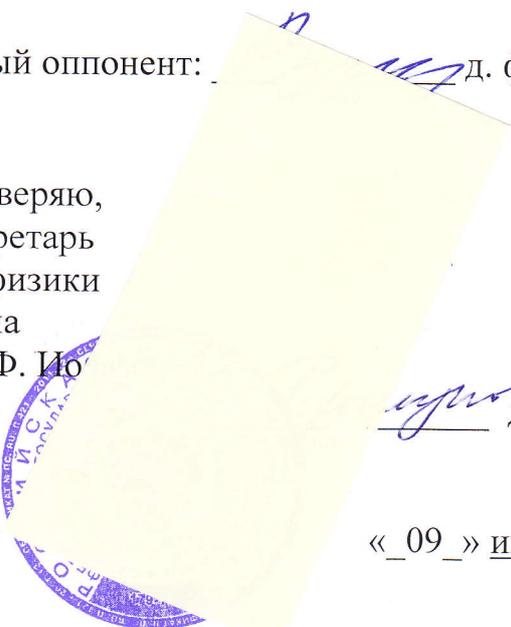


Сведения об официальном оппоненте

по диссертации Шакурова Гильмана Султановича «Высокочастотная ЭПР-спектроскопия примесных парамагнитных ионов в диэлектрических и полупроводниковых кристаллах» по специальности 01.04.11 – Физика магнитных явлений на соискание ученой степени доктора физико-математических наук

Фамилия, имя, отчество	Власенко Леонид Сергеевич
Гражданство	Российская Федерация
Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор физико-математических наук, специальность 01.04.10 – Физика полупроводников и диэлектриков
Ученое звание (по кафедре, специальности)	Старший научный сотрудник
Почтовый индекс, адрес, телефон, web-сайт, электронный адрес организации	194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 26 телефон: (812) 292-22-45, сайт: http://www//ioffe.ru E-mail: post@mail.ioffe.ru
Полное наименование организации в соответствии с уставом	ФГБУН Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН
Наименование подразделения (кафедра/лаборатории)	Лаборатория оптики полупроводников
Должность	Главный научный сотрудник
Публикации по специальности 01.04.11 – Физика магнитных явлений, физико-математические науки (4-5 публикаций за последние пять лет, в том числе обязательно указание публикаций за последние три года)	
1. Vlasenko, L.S Magnetic resonance studies of intrinsic defects in ZnO: Oxygen vacancy / L.S. Vlasenko // Appl.Magn.Reson. – 2010. –Vol. 39. – P. 103-111.	
2. Spin dependent recombination based magnetic resonance spectroscopy of bismuth donor spins in silicon at low magnetic fields / P.A. Mortemousque, T. Sekiguchi, C. Culan, K.M. Itoh, M.P. Vlasenko, L.S. Vlasenko, R.G. Elliman // Appl. Phys. Lett. – 2012. – Vol. 101. – P. 082409.	
3. Identification of photo-induced spin-triplet recombination centers situated at Si surfaces and Si/SiO ₂ interfaces / M. Otsuka, T. Matsuoka, K.M. Itoh, L.S. Vlasenko, M.P. Vlasenko // Appl. Phys. Lett. – 2013. –Vol. 103 – C. 111601.	
4. Identification of a paramagnetic recombination center in silicon/silicon dioxide interface / T. Matsuoka, T. Sekiguchi, K.M. Itoh, L.S. Vlasenko, M.P. Vlasenko // Appl. Phys. Lett. – 2012. – Vol. 100. –P. 152107.	

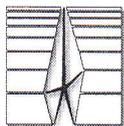
5. Spin dependent recombination involving oxygen vacancy complexes in silicon / D.P. Franke, F. Hoehne, M.S. Brandt, L.S. Vlasenko, K.M. Itoh K.M. // Phys. Rev. B. – 2014. – Vol. 89. – P. 195207.

Официальный оппонент:  д. ф.-м. н., гл.н.с. Власенко Л.С.

Сведения заверяю,
Ученый секретарь
Отделения физики
твердого тела
ФТИ им. А.Ф. Ио

 д. ф.-м. н., Резницкий А.Н.

«_09_» июля 2015 г.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

**Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе
Российской академии наук**

Политехническая ул., 26, С.-Петербург, 194021
Телефон: (812) 297-2245 Факс: (812) 297-1017
post@mail.ioffe.ru http://www.ioffe.ru

09.07.2015 № 11217-545/01/211.5

На № _____ от _____

Председателю
диссертационного совета
Д002. 91.01, д.ф.-м.н.
Академику РАН
К.М. САЛИХОВУ

Согласие выступить официальным оппонентом

Выражаю свое согласие выступить в качестве официального оппонента на защите диссертации Шакурова Гильмана Султановича на тему: «Высокочастотная ЭПР-спектроскопия примесных парамагнитных ионов в диэлектрических и полупроводниковых кристаллах» по специальности: 01.04.11 физика магнитных явлений, представленной на соискание ученой степени доктора физико-математических наук.

Доктор физ.-мат. наук _____ / Власенко Л.С. /

(расшифровка)

Сведения заверяю,
Ученый секретарь
Отделения физики
твёрдого тела
ФТИ им. А.Ф. Иоффе

Резницкий А.Н.
д. ф.-м. н., Резницкий А.Н.

« 09 » июля 2015 г.